



Présentation

Code interne : EE9ME361

Description

Cette formation d'une semaine sur le site de l'AIME donne une approche complète, théorique et pratique, sur les opérations fondamentales de fabrication des circuits intégrés silicium en technologie NMOS, depuis la réception du substrat de silicium jusqu' à la mise en boîtier du composant final et sa caractérisation électrique. Parallèlement, il est procédé à la caractérisation physique des différentes étapes de fabrication.

Le stage se déroule en salle blanche à l'AIME de Toulouse (Atelier Interuniversitaire de Micro-nano-Electronique), pôle CNFM de Toulouse) et fait appel à des moyens matériels lourds.

Heures d'enseignement

TI	Travaux Individuels	12h
TP	Travaux Pratiques	30h

Syllabus

- Oxydation du Wafer
- Gravure et diffusion des zones actives
- Dépôt et gravure du polysilicium de grille
- Ouverture des contacts
- Métallisation
- Test sous pointes
- Mise en boîtier
- Caractérisation électrique

Modalités de contrôle des connaissances

Évaluation initiale / Session principale - Épreuves

Type d'évaluation	Nature de l'épreuve	Durée (en minutes)	Nombre d'épreuves	Coefficient de l'épreuve	Note éliminatoire de l'épreuve	Remarques
Contrôle Continu Intégral	Contrôle Continu			2		

Infos pratiques

Contacts

Eric Kerherve

✉ Eric.Kerherve@bordeaux-inp.fr

Yann Deval

✉ Yann.Deval@bordeaux-inp.fr